

電気通信大学 平成19年度シラバス

授業科目名	半導体工学		
英文授業科目名	Semiconductor Engineering		
開講年度	2007年度	開講年次	3年次
開講学期	前学期	開講コース・課程	夜間主コース
授業の方法		単位数	2
科目区分	専門科目-学科専門科目-選択科目		
開講学科・専攻	電子工学科 量子・物質工学科		
担当教官名	一色 秀夫		
居室	西2 - 517		

公開E-Mail	授業関連Webページ

<p>【主題および達成目標】</p> <p>(a) 主題：IT革命の原動力である半導体デバイスについて、その成り立ちから半導体集積回路の基本要素であるMOSトランジスターの動作原理まで解説する。</p> <p>あらゆる半導体デバイスの基本原理となる半導体界面・接合の物理現象を理解し、それらをどのようにデバイスに利用しているかを学ぶ。</p> <p>(b) 達成目標：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・半導体界面・接合の物理現象の理解 ・半導体デバイスの動作原理の理解 <p>(c) 学習・教育目標との対応</p> <p>科学的思考能力：60%、専門知識とその応用力：20%、継続学習能力：20%</p>

電気通信大学 平成19年度シラバス

【前もって履修しておくべき科目】
基礎電子工学
【前もって履修しておくことが望ましい科目】
なし
【教科書等】
教科書：濱川圭弘編著：半導体デバイス工学、オーム社（2000） 参考書：高橋清 著：半導体工学(第2版)、森北出版（1993）
【授業内容とその進め方】
以下の内容について1～3週で講義を行なう。 1) 半導体デバイス開発の歴史 2) 半導体の電子物性（基礎電子工学の復習） 3) 半導体の界面と接合 4) ダイオード 5) バイポーラ・トランジスター 6) MOSトランジスター
【成績評価方法及び評価基準(最低達成基準を含む)】
(a) 評価方法：レポート、中間試験および期末試験の結果を次の比重で総合評価する。 レポート：40%、中間試験：30%、期末試験：30% (b) 評価基準：最低基準はレポート、中間試験および期末試験の総計で満点の60%の評価点を得ることとする。

電気通信大学 平成19年度シラバス

【オフィスアワー：授業相談】

特に設けない。質問等は電子メールで受け付ける。

【学生へのメッセージ】

半導体は何故電子工学の分野で広く利用されているのか。

IT革命において半導体は何故ここまで活躍しているのか。

その真理を掴んでもらいたい。

【その他】

WEBは第1回目の授業時間にパスワードとともに公開する。